



グローバル COE 物質科学イノベーション講演会

演題：欠陥制御によるペロブスカイト型強誘電体単結晶の高品質化

講師：野口祐二 先生

東京大学先端科学技術研究センター
准教授

日時：2012年3月13日（火） 16:30～17:30

場所：工学部材料・化学棟 5F 大会議室（MC526）

要旨：無機材料において、格子欠陥が悪影響をおよぼして、本来の物性を隠してしまうことがある。Pb系材料の代替物質として期待されているBi系ペロブスカイト型強誘電体では、過去60年間にわたり、欠陥の問題が原因で、基礎物性の評価が可能な単結晶は得られていなかった。本講演では、著者らが世界に先駆けて開発した、高酸素圧下における結晶育成法が、Bi系などの強誘電体の高品質化に極めて有効であることを述べ、その開発の経緯を簡単に紹介する。

連絡先：工学研究院物質化学部門 吉川信一（内線：6739）